



Title	酸素・窒素添加水素化アモルファスシリコンの光電特性および電子輸送の研究
Author(s)	Koarakot, Jiranapakul
Citation	大阪大学, 1987, 博士論文
Version Type	
URL	<a href="https://hdl.handle.net/11094/35369">https://hdl.handle.net/11094/35369</a>
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、<a href=" <a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed">https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed</a> ">大阪大学の博士論文について</a>をご参照ください。

*The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA*

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏名・(本籍)	コラコット・ジラナバーン KOARAKOT JIRANAPAKUL
学位の種類	工学博士
学位記番号	第 7724 号
学位授与の日付	昭和 62 年 3 月 26 日
学位授与の要件	工学研究科電子工学専攻 学位規則第 5 条第 1 項該当
学位論文題目	酸素・窒素添加水素化アモルファスシリコンの光電特性および電子輸送の研究
論文審査委員	(主査) 教授 裏 克己 教授 中村 勝吾 教授 堀 輝雄 教授 浜口 智尋

### 論文内容の要旨

本論文は反応性スパッタ法あるいはグロー放電分解法で作成した水素化アモルファスシリコン ( $a-Si : H$ ) 膜に対する酸素あるいは窒素の添加効果に関する実験的研究をまとめたもので、8 章から成っている。

第 1 章序論では、 $a-Si : H$  の有用性について述べ、酸素・窒素添加効果に関する研究状況と問題点を指摘し、本論文の意義を明らかにしている。

第 2 章では、本研究で用いた試料の作成方法と測定方法を詳述している。

第 3 章では、 $a-Si : H$  および微量の酸素を添加した水素化アモルファスシリコン ( $a-Si : H : O$ ) スパッタ膜の光伝導度および螢光強度がスパッタ時の水素分圧の増加と共に著しく増大することを見出している。増大の機構としてダングリングボンドの不活性化の進展および微結晶シリコン領域の形成による電子移動度の増加を考慮すべきことを明らかにしている。

第 4 章では、 $a-Si : H : O$  スパッタ膜の光学ギャップおよび ESR 中心に対する酸素添加量効果について調べ、微量酸素は主にドナとして膜中に取り込まれるが酸素含有量が 0.2at% を越えると  $SiO_2$  構造の形成のため光学ギャップが増加すること、酸素添加膜中にはシリコンダングリングボンド以外に g 値が 1.934 の新しい ESR 中心が形成されることを見出している。

第 5 章では、 $a-Si : H : O$  スパッタ膜の電子輸送現象を詳しく調べ、微量酸素の添加により電水伝導が非分散になり電子移動度が大きくなることを見出している。

第 6 章では、 $a-Si : H : O$  スパッタ膜の光伝導度の酸素添加量効果について述べており、微量酸素

の添加による光伝導度の顕著な増大の機構を明らかにし、電子寿命とシリコンダングリングボンド密度とはほぼ反比例の関係にあることを見出している。

第7章では、 $a-Si:H$  グロー放電膜の電子移動度に対する窒素添加効果を述べており、窒素添加による電子移動度の単調な減少を見出している。

第8章は結論で、本研究の成果を総括している。

### 論文の審査結果の要旨

本論文は、新しい電子材料である水素化アモルファスシリコン ( $a-Si:H$ ) に対する酸素および窒素の添加効果を明らかにするために行った一連の研究をまとめたもので、成果を要約すると次のとおりである。

- (1)  $a-Si:H$  スパッタ膜の光伝導度および螢光強度が成膜時の水素分圧の増加と共に顕著な増大を示すことを初めて見出している。また、微量の酸素を添加した  $a-Si:H$  膜においても同様の効果があることを確かめている。
- (2)  $a-Si:H$  膜中の酸素の効果が添加量によって異なり、微量の時には主にドナとして働き、0.2at%を越すと  $SiO_2$  構造を構成してエネルギーギャップの増大に寄与することを明らかにしている。
- (3)  $a-Si:H$  スパッタ膜は通常分散性電子伝導を示すが、微量の酸素を添加することによって電子伝導は非分散性となり電子移動度が大きくなることを見出している。また、その原因として、従来提唱されている2配位酸素による構造歪みの緩和以外に、酸素によって導入されるドナ準位の効果が大きいことを初めて指摘している。
- (4)  $a-Si:H$  スパッタ膜の電子移動度および電子寿命の酸素添加効果を個別に測定して微量酸素の添加による光伝導度の増大の機構を明らかにしている。

以上のように、本論文は  $a-Si:H$  膜に対する主要ガス不純物の効果を種々の角度から明らかにし、 $a-Si:H$  膜の応用上有用な知見を多く得ており、電子工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。